【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2004-523454(P2004-523454A)
【公表日】平成16年8月5日(2004.8.5)
【年通号数】公開・登録公報2004-030
【出願番号】特願2002-552867(P2002-552867)
【国際特許分類】
Ｃ０３Ｂ　37/014　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０３Ｂ　37/014　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成17年4月6日(2005.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
スート・プリフォームを炉中で、一酸化炭素を含むが実質的に塩素を含まない雰囲気に暴露し、
前記スート・プリフォームを少なくとも約１０００℃の温度に加熱する、
各工程を有してなる、光ファイバのプリフォームを作製する方法。
【請求項２】
前記雰囲気が少なくとも約１００ｐｐｍの一酸化炭素を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
スート本体をフッ素でドープし、
前記フッ素でドープしたスート本体を、少なくとも一酸化炭素を含み実質的に塩素を含まない雰囲気に、少なくとも１１００℃の温度で暴露し、それによって、存在している過剰の酸素を反応させる、
各工程を有してなる、光ファイバを作製する方法。
【請求項４】
前記暴露中の雰囲気内のＣＯ濃度が、前記ドーピング工程のドーピング雰囲気中のフッ素濃度と同じオーダであることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
スート本体を、少なくとも一酸化炭素およびフッ素含有化合物を含み、実質的に塩素を含まない雰囲気に、少なくとも１１００℃の温度で暴露し、それによって、存在している過剰の酸素を反応させる工程を有してなる、光ファイバを作製する方法。